

AN 1995:217051 CAPLUS
 DN 122:162556
 ED Entered STN: 30 Nov 1994
 TI Epoxy resin compositions and packaged semiconductor devices resistant to moisture and solder heat
 IN Sawai, Kazuhiro; Yokochi, Hitoshi
 PA Toshiba Chem Prod, Japan
 SO Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 6 pp.
 CODEN: JKXXAF
 DT Patent
 LA Japanese
 IC ICM C08G059-24
 ICS C08G059-62; C08L063-00; H01L023-29; H01L023-31
 CC 37-6 (Plastics Manufacture and Processing)
 Section cross-reference(s): 38, 76

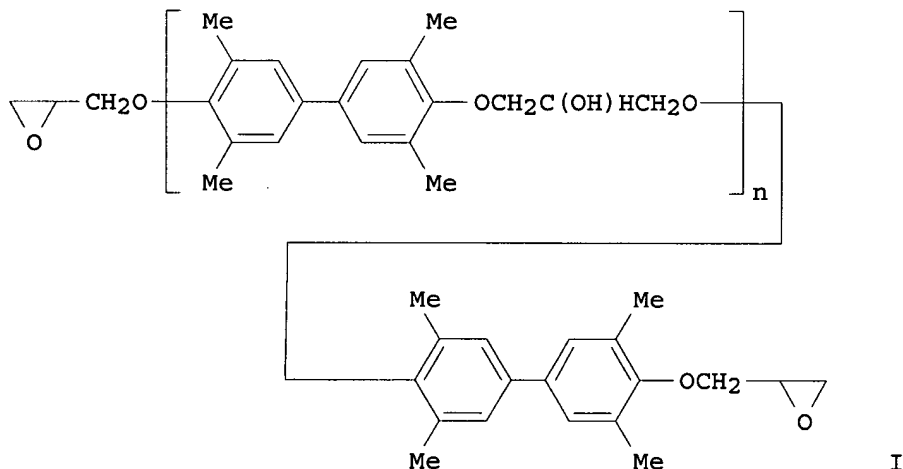
FAN.CNT 1

PATENT NO.	KIND	DATE	APPLICATION NO.	DATE
PI JP 06239968	A2	19940830	JP 1993-50066	19930216
PRAI JP 1993-50066		19930216		

CLASS

PATENT NO.	CLASS	PATENT FAMILY CLASSIFICATION CODES
JP 06239968	ICM	C08G059-24
	ICS	C08G059-62; C08L063-00; H01L023-29; H01L023-31
	IPCI	C08G0059-24 [ICM,5]; C08G0059-62 [ICS,5]; C08L0063-00 [ICS,5]; H01L0023-29 [ICS,5]; H01L0023-31 [ICS,5]

GI



AB The title devices contain semiconductor chips packaged by the title epoxy resin compns. containing epoxy resins I ($n \geq 0$ integer), resol-type phenolic resins (RPR), and 25-90% (based on the resin composition) inorg. fillers. Thus I ($n = 0$) 17, RPR 7, powdered silica 75, curing accelerator 0.3, ester wax 0.3, and silane coupling agent 0.4% were mixed at room temperature, kneaded at 90-95°, cooled, and crushed to give a molding material, which was transfer injected in a 170°-mold, semiconductor chip was packaged, and cured to give a test piece with moisture absorption 0.54% after 24 h at 127° and 2.5-atm moisture, glass transition temperature 164° and JIS K 6911 bending strength at room temperature 17.1 kg/mm² and at 220° 3.0 kg/mm². Si chips with ≥ 2 Al wires were bonded to a 42 alloy

frame with the composition, transfer molded at 175° for 2 min, and cured at 175° for 8 h to give a test piece showing PCT test resistance.

ST epoxy resin semiconductor device packaging; spotting resistance epoxy resin packaging

IT Electronic device packaging

Heat-resistant materials

Semiconductor devices

(epoxy resin compns. containing inorg. fillers for semiconductor device packagings with good spotting resistance)

IT Epoxy resins, preparation

RL: IMF (Industrial manufacture); PRP (Properties); TEM (Technical or engineered material use); PREP (Preparation); USES (Uses)

(phenoxy, epoxy resin compns. containing inorg. fillers for semiconductor device packagings with good spotting resistance)

IT Phenolic resins, preparation

RL: IMF (Industrial manufacture); PRP (Properties); TEM (Technical or engineered material use); PREP (Preparation); USES (Uses)

(resol, reaction products with bisphenol-type diglycidyl ethers; epoxy resin compns. containing inorg. fillers for semiconductor device packagings with good spotting resistance)

IT 85954-11-6DP, reaction products with resol-type phenolic resins

RL: IMF (Industrial manufacture); PRP (Properties); TEM (Technical or engineered material use); PREP (Preparation); USES (Uses)

(epoxy resin compns. containing inorg. fillers for semiconductor device packagings with good spotting resistance)

IT 7631-86-9, Silica, uses

RL: MOA (Modifier or additive use); USES (Uses)

(epoxy resin compns. containing inorg. fillers for semiconductor device packagings with good spotting resistance)

DERWENT-ACC-NO: 1994-313749

DERWENT-WEEK: 199439

COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Filled epoxy! resin compsn. contg. resol phenol! resin
having excellent moisture resistance for sealing
semiconductor sealing

PATENT-ASSIGNEE: TOSHIBA CHEM CORP [DSM]

PRIORITY-DATA: 1993JP-0050066 (February 16, 1993)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	MAINIPC
<u>JP 06239968 A</u>	August 30, 1994	N/A	006	C08G 05/24

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DESCRIPTOR	APPL-NO	APPL-DATE
JP 06239968A	N/A	1993JP0050066	February 16, 1993

INT-CL (IPC): C08G059/24, C08G059/62, C08D63/00, H01L023/29, H01L023/31

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 06239968A

BASIC-ABSTRACT:

Epoxy resin compsn. comprises (A) epoxy resin of formula (I), (B) resol-based phenolic resin and (C) inorganic filler, wherein content of (C) is 2-90 wt.% of the resin compsn. In formula (I), n = 0 or at least 1; and G = glycidyl gp.. Also claimed: semiconductor sealing device comprises a semiconductor chip sealed with a cured product of the epoxy resin compsn..

USE/ADVANTAGE - Compsn. is used in semiconductor sealing. Product excels in resistance to moisture and solder heat and is not much affected by absorption of moisture and causes much less current leakage.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

TITLE-TERMS: FILLED POLYEPOXIDE RESIN COMPOSITION CONTAIN RESOL POLYPHENOL
RESIN MOIST RESISTANCE SEAL SEMICONDUCTOR SEAL

DERWENT-CLASS: A21 A85 L03 U11

CPI-CODES: A05-A02; A05-C01A; A08-D; A08-R01; A12-E04; A12-E07C; L04-C20A;

EPI-CODES: U11-A07;

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 1694U

ENHANCED-POLYMER-INDEXING:

Polymer Index [1.1]

017 ; H0022 H0011 ; G1570*R G1558 D01 D11 D10 D23 D22 D31 D42 D50
D69 D83 F47 7A ; G1252 G1150 G1149 G1092 D01 D18 F32 F30 D11 D10
D19 D32 D50 D93 ; P0055 ; P0464*R D01 D22 D42 F47 ; M9999 M273
; S9999 S1434

Polymer Index [1.2]

017 ; ND04 ; Q9999 Q7374*R Q7330 ; Q9999 Q7476 Q7330 ; Q9999 Q7523
; B9999 B4717 B4706 B4568 ; B9999 B4682 B4568 ; B9999 B3407 B3383
B3372 ; B9999 B5618 B5572 ; B9999 B4148 B4091 B3838 B3747 ; B9999
B3178 ; K9461 ; B9999 B3849*R B3838 B3747 ; N9999 N6439 ; N9999
N6144 ; N9999 N5812*R ; K9449

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-239968

(43)公開日 平成6年(1994)8月30日

(51)Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
C 0 8 G 59/24	NH Q	8416-4 J		
59/62	N J S	8416-4 J		
C 0 8 L 63/00	N K T	8830-4 J		
H 0 1 L 23/29				
	8617-4M	H 0 1 L 23/ 30	R	
	審査請求	未請求	請求項の数 2	FD (全 6 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願平5-50066

(22)出願日 平成5年(1993)2月16日

(71)出願人 390022415

東芝ケミカル株式会社

東京都港区新橋3丁目3番9号

(72)発明者 沢井 和弘

埼玉県川口市領家5丁目14番25号 東芝ケ

ミカル株式会社川口工場内

(72)発明者 横内 比斗志

埼玉県川口市領家5丁目14番25号 東芝ケ

ミカル株式会社川口工場内

(74)代理人 弁理士 諸田 英二

(54)【発明の名称】 エポキシ樹脂組成物および半導体封止装置

(57)【要約】

【構成】 本発明は、(A)テトラメチル-p,p'-ジフェノールとエピクロルヒドリンを反応されて得られる構造のエポキシ樹脂、(B)レゾール系のフェノール樹脂および(C)無機質充填剤を必須成分とし、樹脂組成物に対して前記(C)の無機質充填剤を25~90重量%の割合で含有してなるエポキシ樹脂組成物である。また、このエポキシ樹脂組成物の硬化物によって、半導体チップを封止した半導体封止装置である。

【効果】 本発明のエポキシ樹脂組成物および半導体封止装置は、耐湿性、半田耐熱性に優れ、吸湿による影響が少なく、電極の腐蝕による断線や水分によるリーク電流の発生等を著しく低減することができ、しかも長期間にわたって信頼性を保証することができる。

1

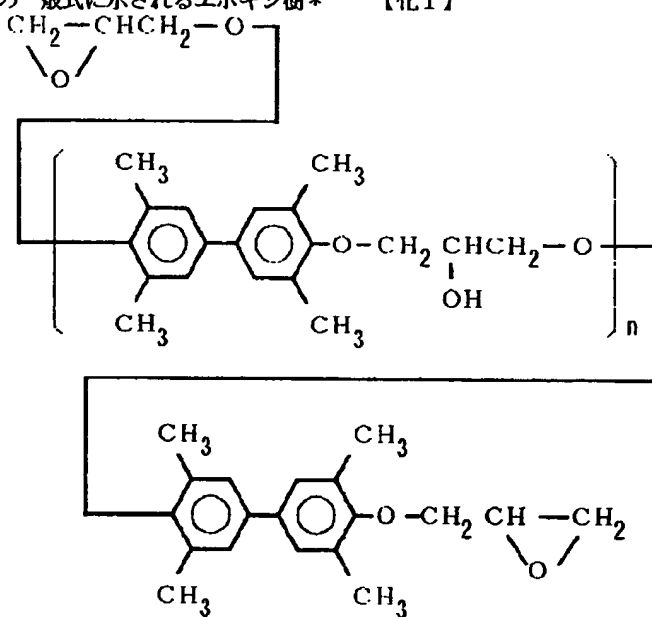
2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 次の一般式に示されるエポキシ樹*

* 脂、

【化1】



(但し、式中n は 0又は 1以上の整数を表す)

(B) レゾール系フェノール樹脂および

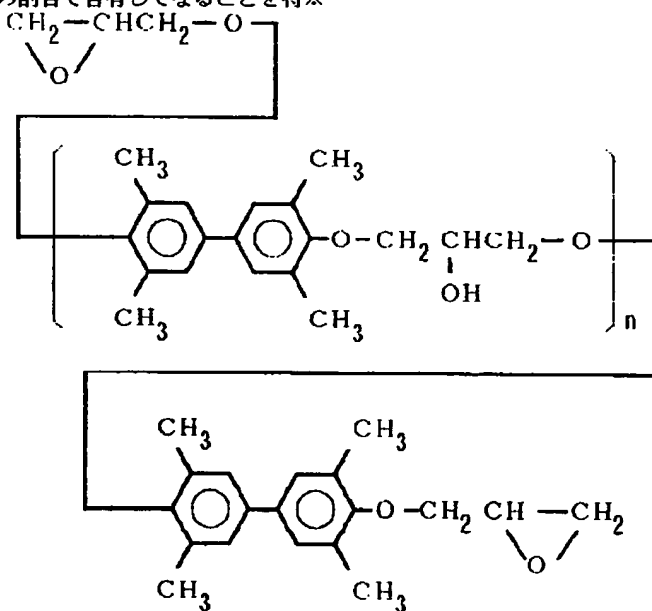
(C) 無機質充填剤

を必須成分とし、樹脂組成物に対して前記(C)の無機質充填剤を25~90重量%の割合で含有してなることを特※

※微とするエポキシ樹脂組成物。

【請求項2】 (A) 次の一般式で示されるエポキシ樹脂、

【化2】



(但し、式中n は 0又は 1以上の整数を表す)

(B) レゾール系フェノール樹脂および

(C) 無機質充填剤

を必須成分とし、樹脂組成物に対して前記(C)の無機質充填剤を25~90重量%の割合で含有したエポキシ樹脂組成物の硬化物によって、半導体チップが封止されてなることを特徴とする半導体封止装置。

★【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、耐湿性、半田耐熱性に優れたエポキシ樹脂組成物および半導体封止装置に関する。

【0002】

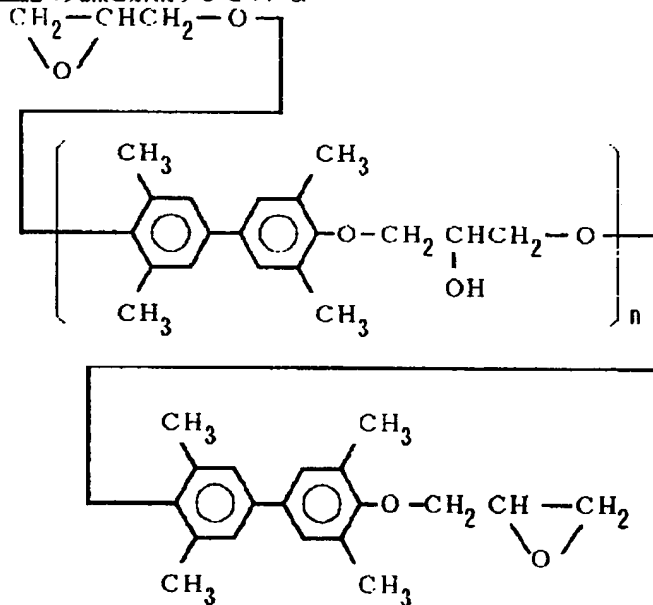
★50 【従来の技術】近年、半導体集積回路の分野において、

高集積化、高信頼性化の技術開発と同時に半導体装置の実装工程の自動化が推進されている。例えばフラットパッケージ型の半導体装置を回路基板に取り付ける場合に、従来、リードピン毎に半田付けを行っていたが、最近では半田浸漬方式や半田リフロー方式が採用されている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】従来のノボラック型エポキシ樹脂等のエポキシ樹脂、ノボラック型フェノール樹脂およびシリカ粉末からなる樹脂組成物によって封止した半導体装置は、装置全体の半田浴浸漬を行うと耐湿性が低下するという欠点があった。特に吸湿した半導体装置を浸漬すると、封止樹脂と半導体チップ、あるいは封止樹脂とリードフレームとの間の剥がれや、内部樹脂クラックが生じて著しい耐湿性劣化を起し、電極の腐蝕による断線や水分によるリーク電流を生じ、その結果、半導体装置は、長期間の信頼性を保証することができないという欠点があった。

【0004】本発明は、上記の欠点を解消するためにな*



(但し、式中n は 0又は 1以上の整数を表す)

(B) レゾール系フェノール樹脂および

(C) 無機質充填剤

を必須成分とし、樹脂組成物に対して前記(C)の無機質充填剤を25~90重量%の割合で含有してなることを特徴とするエポキシ樹脂組成物である。また、このエポキシ樹脂組成物の硬化物によって、半導体チップが封止されてなることを特徴とする半導体封止装置である。 ※

*されたもので、吸湿の影響が少なく、特に半田浴浸漬後の耐湿性、半田耐熱性に優れ、封止樹脂と半導体チップあるいは封止樹脂とリードフレームの間の剥がれや、内部樹脂クラックの発生がなく、また電極の腐蝕による断線や水分によるリーク電流の発生もなく、長期信頼性を保証できるエポキシ樹脂組成物および半導体封止装置を提供しようとするものである。

【0005】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の目的を達成しようと鋭意研究を重ねた結果、特定のエポキシ樹脂、硬化剤として特定のフェノール樹脂を用いることによって、耐湿性、半田耐熱性に優れた樹脂組成物が得られることを見だし、本発明を完成したものである。

【0006】即ち、本発明は、

(A) 次の一般式で示されるエポキシ樹脂、

【0007】

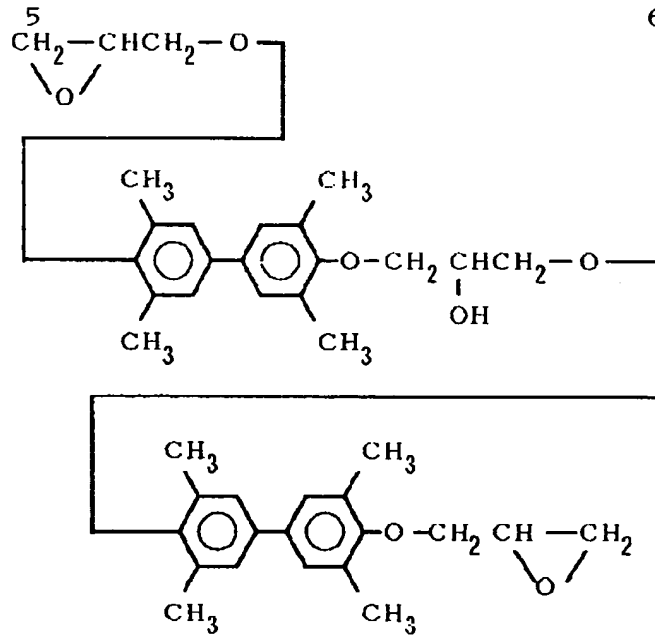
【化3】

※【0008】以下、本発明を詳細に説明する。

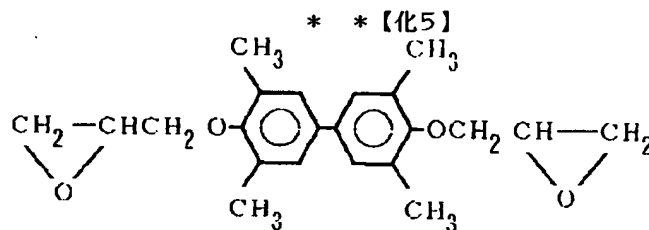
【0009】本発明に用いる(A)エポキシ樹脂は、前記の一般式で示されるものが使用され、その分子量等に制限されることなく使用することができる。具体的な化合物として、例えば

【0010】

【化4】



【0011】



等が挙げられ、これらは単独又は混合して使用することができる。また、このエポキシ樹脂には、ノボラック系エポキシ樹脂やエビス系エポキシ樹脂、その他一般に公知のエポキシ樹脂を併用することができる。

【0012】本発明に用いる(B)レゾール系フェノール樹脂としては、フェノールとホルムアルデヒドをアルカリ性触媒で反応させて得られるメチロール基を有する生成物であればよく、特に制限はなく広く使用することができる。これらのレゾール系フェノール樹脂は、単独又は混合して使用することができる。また、このフェノール樹脂にはフェノール、アルキルフェノール等のフェノール類とホルムアルデヒドあるいはパラホルムアルデヒドとを反応させて得られるノボラック型フェノール樹脂およびこれらの変性樹脂を併用することができる。

【0013】本発明に用いる(C)無機質充填剤としては、一般に使用されているものが広く使用されるが、それらの中でも不純物濃度が低く、平均粒径 $30\mu\text{m}$ 以下のシリカ粉末が好ましく使用される。平均粒径 $30\mu\text{m}$ を超えると耐湿性および成形性が劣り好ましくない。無機質充填剤の配合割合は、全体の樹脂組成物に対して25~90重量%含有するように配合することか好ましい。その割合が25重量%未満では樹脂組成物の吸湿性が高く、半田浸漬後の耐湿性に劣り、また90重量%を超えると極端に流動性が悪くなり、成形性に劣り好ましくない。

【0014】本発明のエポキシ樹脂組成物は、前述した※50

※特定のエポキシ樹脂、特定のフェノール樹脂および無機質充填剤を必須成分とするが、本発明の目的に反しない限度において、また必要に応じて、例えば天然ワックス類、合成ワックス類、直鎖脂肪酸の金属塩、酸アミド類、エステル類、パラフィン類等の離型剤、三酸化アンチモン等の難燃剤、カーボンブラック等の着色剤、シランカップリング剤、種々の硬化促進剤、ゴム系やシリコン系の低応力付与剤等を適宜添加配合することができる。

【0015】本発明のエポキシ樹脂組成物を成形材料として調製する場合の一般的方法は、前述した特定のエポキシ樹脂、特定のフェノール樹脂、無機質充填剤およびその他の成分を配合し、ミキサー等によって十分に混合した後、さらに熱ロールによる溶融混合処理またはニーダ等による混合処理を行い、次いで冷却固化させ適当な大きさに粉砕して成形材料とすることができる。こうして得られた成形材料は、半導体装置をはじめとする電子部品或いは電気部品の封止・被覆・絶縁等に適用すれば優れた特性と信頼性を付与させることができる。

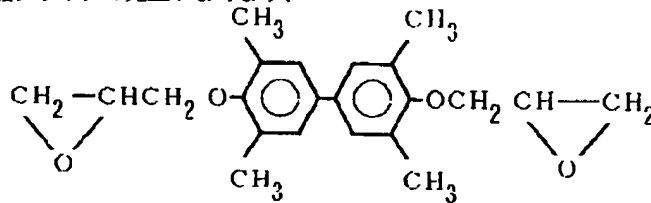
【0016】また、本発明の半導体封止装置は、上述の成形材料を用いて半導体チップを封止することにより容易に製造することができる。封止を行う半導体装置としては、例えば集積回路、大規模集積回路、トランジスタ、サイリスタ、ダイオード等で特に限定されるものではない。封止の最も一般的な方法としては、低圧トラン

7

スファア成形法があるが、射出成形、圧縮成形、注形等による封止も可能である。成形材料で封止後加熱して硬化させ、最終的にはこの硬化物によって封止された半導体封止装置が得られる。加熱による硬化は、150℃以上に加熱して硬化させることが望ましい。

【0017】

【作用】本発明のエポキシ樹脂組成物および半導体封止装置は、特定のエポキシ樹脂とレゾール系フェノール樹脂を用いることによって、樹脂組成物のガラス転移温度が上昇し、熱機械的特性と低応力性が向上し、半田浸漬、半田リフロー後の樹脂クラックの発生がなくなり、*



レゾール系フェノール樹脂（融点78℃）7%、シリカ粉末75%、硬化促進剤 0.3%、エステルワックス類 0.3%およびシランカップリング剤 0.4%を常温で混合し、さらに90～95℃で混練冷却した後、粉砕して成形材料（A）を製造した。

【0021】実施例2

化6のエポキシ樹脂9%、実施例1で用いたレゾール系フェノール樹脂 4%、αクレゾールノボラック型エポキシ樹脂8%、ノボラック型フェノール樹脂4%、シリカ粉末74%、硬化促進剤 0.3%、エステルワックス類 0.3%およびシランカップリング剤 0.4%を常温で混合し、さらに90～95℃で混練冷却した後、粉砕して成形材料（B）を製造した。

【0022】比較例1

αクレゾールノボラック型エポキシ樹脂17%、ノボラック型フェノール樹脂 8%、シリカ粉末74%、硬化促進剤 0.3%、エステルワックス類 0.3%およびシランカップリング剤 0.4%を常温で混合し、さらに90～95℃で混練※

8

*耐湿性劣化が少なくなるものである。

【0018】

【実施例】次に本発明を実施例によって説明するが、本発明はこれらの実施例によって限定されるものではない。以下の実施例および比較例において「%」とは「重量%」を意味する。

【0019】実施例1

次の化6に示したエポキシ樹脂17%、

【0020】

【化6】

※冷却した後、粉砕して成形材料（C）を製造した。

【0023】比較例2

20 エピビス型エポキシ樹脂（エポキシ当量 450）20%、ノボラック型フェノール樹脂 5%、シリカ粉末74%、硬化促進剤 0.3%、エステルワックス類 0.3%およびシランカップリング剤 0.4%を常温で混合し、さらに90～95℃で混練冷却した後、粉砕して成形材料（D）を製造した。

【0024】こうして製造した成形材料（A）～（D）を用いて 170℃に加熱した金型内にトランスファー注入、半導体チップを封止し硬化させて半導体封止装置を製造した。これらの半導体封止装置について、諸試験を行ったのでその結果を表1に示したが、本発明のエポキシ樹脂組成物および半導体封止装置は、耐湿性、半田耐熱性に優れており、本発明の顕著な効果を確認することができた。

【0025】

【表1】

特性	実施例		比較例	
	1	2	1	2
成形材料	A	B	C	D
吸水率 (%) * ¹	0.54	0.59	0.60	0.64
ガラス転移温度 (°C) * ²	164	161	160	135
曲げ強さ (kgf/mm ²) * ³				
常温	17.1	16.5	14.2	13.1
220 °C	3.0	2.8	2.0	1.5
PCT [半田浴浸漬後] * ⁴ (不良数/試料数)				
20 h	0/20	0/20	0/20	0/20
40 h	0/20	0/20	5/20	0/20
100 h	0/20	0/20	20/20	1/20
200 h	0/20	0/20	—	1/20
300 h	0/20	0/20	—	20/20
400 h	0/20	0/20	—	—
500 h	0/20	4/20	—	—
1000 h	5/20	10/20	—	—
耐クラック性 (不良数/試料数) * ⁵	0/12	4/12	12/12	12/12

*1 : トランスファー成形によって直径50mm、厚さ3mmの成形品を作り、これを127 °C、2.5気圧の飽和水蒸気中に24時間放置し、増加した重量によって測定した。

*2 : 吸水率の場合と同様な成形品を作り、175 °C、8時間の後硬化を行い、適当な大きさの試験片とし、熱機械分析装置を用いて測定した。

*3 : JIS-K-6911に準じて試験した。

*4 : 成形材料を用いて、2本以上のアルミニウム配線を有するシリコン製チップを、通常の42アロイフレームに接着し、175 °C、2分間トランスファー成形した後、175 °C、8時間の後硬化を行った。こうして得た成形品を、予め40°C、95%RH、100時間の吸湿処理した後、250 °Cの半田浴に10秒間浸漬した。その後、127 °C、2.5気圧の飽和水蒸気中でPCTを行い、アルミニウムの腐蝕による50%断線を不良として評価した。 *

*5 : 8 × 8mm ダミーチップをQFP (14 × 14 × 1.4mm) パッケージに納め、成形材料を用いて175 °C、2分間トランスファー成形した後、175 °C、8時間の後硬化を行った。こうして得た半導体封止装置を85°C、85%、24時間の吸湿処理した後、240 °Cの半田浴に1分間浸漬した。その後、実体顕微鏡でパッケージ表面を観察し、外部樹脂クラックの発生の有無を評価した。

【0026】

【発明の効果】以上の説明および表1から明らかなように、本発明のエポキシ樹脂組成物および半導体封止装置は、耐湿性、半田耐熱性に優れ、吸湿による影響が少なく、電極の腐蝕による断線や水分によるリーク電流の発生等を著しく低減することができ、しかも長期間にわたって信頼性を保証することができる。

フロントページの続き

(51)Int. Cl.⁵

H01L 23/31

識別記号

庁内整理番号

FI

技術表示箇所